

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PGS

Mã hồ sơ:



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: **TRẦN VĂN QUẢNG**

2. Ngày tháng năm sinh: 05/08/1982; Nam ☒; Nữ ☐; Quốc tịch: VIỆT NAM;

Dân tộc: KINH Tôn giáo: KHÔNG

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☒

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 513b, tập thể E5, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 3103 S2, Chung cư Seasons Avenue CT09, Khu Cổ Ngựa, Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0945 19 1492 ;

E-mail: tkuangv@gmail.com

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 2004 đến năm 2006 là giáo viên hợp đồng, khối chuyên Vật lý, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội

Từ năm 2006 đến nay là giảng viên Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải.

Từ năm 2009 đến năm 2014 là nghiên cứu sinh tại Đại Học Ajou, Hàn Quốc

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

Từ năm 2014 đến năm 2015 nghiên cứu sau tiến sỹ tại Viện nghiên cứu khoa học tự nhiên, Đại Học Sookmyung, Hàn Quốc.

Từ năm 2016 đến nay là cán bộ nghiên cứu hợp đồng hợp tác nghiên cứu, Trường Đại Học Duy Tân, Đà Nẵng.

Chức vụ hiện nay: *Giảng viên chính*; Chức vụ cao nhất đã qua: *Giảng viên chính*

Cơ quan công tác hiện nay: *Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải*

Địa chỉ cơ quan: *Số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội*

Điện thoại cơ quan 0243 7664050

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ thángnăm

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 06 năm 2004 , ngành: *Sư phạm Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.*

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): *Khoa sư phạm (Nay là Trường Đại học Giáo dục), Đại Học Quốc Gia Hà Nội*

- Được cấp bằng ThS ngày 16 tháng 03 năm 2007, ngành: *Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.*

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): *Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.*

- Được cấp bằng TS ngày 14 tháng 08 năm 2014, ngành: *Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.*

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): *Đại Học Ajou, Hàn Quốc.*

- Được cấp bằng TSKH ngày ... tháng ... năm ..., ngành:, chuyên ngành:

.....

Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước):

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày tháng năm , ngành:

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh **PGS** tại HĐGS cơ sở: **Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải**

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh **PGS** tại HĐGS ngành, liên ngành: *Vật lý*

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu các tính chất của vật liệu, trong đó tập trung chủ yếu vào nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng, tính chất nhiệt điện và tính chất từ của vật liệu khối và màng mỏng.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng): 03 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên (số lượng): 04 đề tài gồm 03 đề tài NCKH cấp Cơ sở, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải và 01 đề tài NCKH NAFOSTED, thuộc quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
- Đã công bố (số lượng) 27 bài báo KH, trong đó 09 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín, 15 bài báo KH trong nước và 3 bài báo quốc tế;
- Đã được cấp (số lượng) bằng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản: 02, trong đó thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Guang mặt trẻ tiêu biểu Đại Học Quốc Gia Hà Nội	Đại Học Quốc Gia Hà Nội	2003
2	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải	2016
3	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở	Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải	2017
4	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở	Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải	2018
5	Giấy khen Hiệu trưởng	Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải	2018
6	Đóng góp trong phong trào thi Olympic Vật lý toàn quốc	Hội vật lý Việt Nam	2019
7	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở	Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải	2019
8	Bằng khen Bộ Trưởng	Bộ Giáo Dục Đào Tạo	2019

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): **Không**

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: *Phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Luôn có ý thức cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục. Luôn khách quan trong đào tạo. gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo. Luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của*

nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học. Không ngừng học tập rèn luyện để hoàn thiện bản thân, phục vụ công tác giảng dạy và NCKH trong nhà trường. Luôn có ý thức nỗ lực đóng góp phát triển trường Đại Học Giao Thông Vận tải thông qua các hoạt động giảng dạy và hướng dẫn sinh viên NCKH với các vấn đề có tính thời sự, thực tiễn gắn với nhà trường.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*):

- Tổng số 12 năm. (Giảng dạy Vật lý Đại Cương tại trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội; thời gian từ 9/2009 đến 3/2015 được nhà trường cử đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài)

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/giờ quy đổi/Số giờ định mức
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2008-2009					320		320/696.1/280
2	2015-2016					595		595/929/270
3	2016-2017					390		390/560/270
3 năm học cuối								
4	2017-2018			1		300		300/460.9/270
5	2018-2019			1		345		345/604.7/270
6	2019-2020			1		330		330/330/270

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài: ☒

- Học ĐH ☐; Tại nước:; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☒ hoặc ☐ TSKH; Tại nước: **Hàn Quốc năm 2014**

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: ☐

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ:số bằng:; năm cấp:.....

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: ☒

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: **Tiếng Anh**

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

(1) Trường Đại Học Sookmyung, Hàn Quốc (Giảng dạy chuyên đề: “*Physics of thermoelectric and magneto-electric effects: First-principles calculation*” từ 19/8/2019 đến 8/9/2019)

(2) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Giảng dạy Vật lý bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiến của trường)

d) Đối tượng khác ☒ ; Diễn giải: *Chúng nhận nghiên cứu sau tiến sỹ tại Hàn Quốc; Đọc hiểu các bài báo và các tài liệu chuyên môn; viết các bài báo chuyên môn; trình bày, thảo luận báo cáo tại các hội nghị Quốc tế tổ chức trong nước và quốc tế.*

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): *Bằng tiến sỹ và chứng nhận Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Hàn Quốc; Thư xác nhận giảng chuyên đề tại Hàn Quốc; chứng nhận hoạt động khoa học tại ICTP, Italy; Giấy mời tham dự các hội nghị Quốc tế ở ngoài nước.*

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Đinh Thị Mến		HV	Chính		12/2017 đến 12/2018	Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội I	2018
2	Nguyễn Bích Ngọc		HV	Chính		08/2018 đến 07/2019	Học Viện Khoa Học Và Công Nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam	2019
3	Nguyễn Văn Hùng		HV	Chính		02/2019 đến 02/2020	Trường Đại Học Hồng Đức, Tỉnh Thanh Hóa	2020

Ghi chú: Học viên Nguyễn Văn Hùng đã có giấy chứng nhận và quyết định phát bằng, nhưng nhà trường chưa tổ chức phát bằng.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phản biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
----	----------	----------------------------	------------------------------	------------	----------	---	--

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
1	Phương Pháp Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương	Sách tham khảo	Nhà xuất bản thế giới 2007	3	VC	Từ tr.143- tr.228; và từ tr.355- tr.410;	GPXB: 595- 2007/CXB/2- 176/thG
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
2	Vật lý	Giáo trình	Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, 2016	4	VC	Viết chương 4 và 5 Từ trang 70 đến trang 117	Giáo trình trong trường ĐHGTVT ISBN: 978-604- 76-0743-3 Quyết định số: 101/QĐ-GTVT 28/10/2015

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS:

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).
- **Các chữ viết tắt:** CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) /Xếp loại KQ
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	<i>Gần đúng eikonal trong lý thuyết trường lượng tử (ĐT)</i>	CN	T2007-CB- 67, cấp cơ sở, Trường ĐHGTVT	1/1/2007- 31/12/2007	24-9-2007/Tốt
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) /Xếp loại KQ
2	Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu tác động của thay thế nguyên tố và nén tinh thể lên cấu trúc vùng và tính chất nhiệt điện của một số bán dẫn điển hình và nghiên cứu tính chất từ của một số màng mỏng trong điện trường ngoài (ĐT)	CN	103.01- 2015.11, cấp bộ, Quỹ Phát Triển KH&CN Quốc Gia NAFOSTED.	1/5/2015- 30/4/2018	04-2018/Đạt (Ngày ban hành kết luận 27/06/2018)
3	Nghiên cứu sự phụ thuộc của cấu trúc mạng và tính chất nhiệt điện vào áp suất bằng phương pháp FLAPW trong lý thuyết phiếm hàm mật độ và lý thuyết Boltzmann (ĐT)	CN	T2016- KHCB-62, cấp cơ sở, Trường ĐHGTVT	1/1/2016- 31/12/2016	17-10-2016/Tốt
4	Tác dụng của nén tinh thể lên tính chất vật lý của tinh thể hợp kim nano silicon-germanium pha tạp (ĐT)	TK	T2018-CB- 003, cấp cơ sở, Trường ĐHGTVT	1/1/2018- 31/12/2018	12-12-2018/Tốt

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- **Các chữ viết tắt:** CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, Trang	Năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	<i>Spin dynamics of antiferromagnetic heisenberg systems on the triangular lattice with a strict single site occupation</i>	03	Có	Communications in Physics/ ISSN: 0868-3166			19,2,71-76	2009
2	<i>Temperature and carrier-concentration dependences of the thermoelectric properties of bismuth selenide dioxide compounds</i>	03	Có	Journal of the Korean Physical Society/ ISSN: 0374-4884 ; e-ISSN: 1976-8524	SCI IF:0.6; Q3)	18	61,10,1728-1731	2012
3	<i>Electronic structure and magneto-optical properties of Co₂MnX alloys where X = Ge, Sn and Pb: a first-principles investigation in the LDA+U approach</i>	03	Có	Journal of the Korean Physical Society/ ISSN: 0374-4884; e-ISSN: 1976-8524	SCI (IF:0,6 ; Q3)	4	62,12,2184-2187	2013
4	<i>Spin-orbit Coupling Effect on the Structural Optimization; Bismuth Telluride in First-principles</i>	02	Có	Journal of The Korean Magnetics Society/ ISSN (Print): 1598-5385; e-ISSN: 2233-6648	ESCI		23,1,23/(1):1-6	2013
5	<i>The metal-insulator phase transition in the strained GdBiTe₃</i>	02	Có	Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979 e-ISSN: 1089-7550	SCI (IF:2,3 ; Q1)		113,N/A,17A934-17A934-3	2013

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập,số ,Trang	Năm công bố
6	<i>Effect on the Electronic, Magnetic and Thermoelectric Properties of Bi₂Te₃ by the Cerium Substitution</i>	02	Có	IEEE Transactions on Magnetics/ISSN: 0018-9464	SCI (IF:1,7 ; Q2)	4	50,1,1000904	2014
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
7	<i>Ứng dụng trạng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu trạng thái nền của SbBiTe₃</i>	01	Có	<i>Tạp chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải</i> /ISSN: 1859-2724			N/A, 48, 65	10/2015
8	<i>Nanocrystal growth of single-phase Si_{1-x}Ge_x alloys</i>	05	Không	Journal of Physics and Chemistry of Solids/ISSN: 0022-3697	SCI (IF:2,8 ; Q2)	8	93, N/A, 121-125	2016
9	<i>Electronic Structures and Thermoelectric Properties of Layered Chalcogenide PbBi₄Te₇ from First-Principles</i>	02	Có	Journal of the Korean Physical Society/ISSN: 0374-4884;e-ISSN: 1976-8524	SCI (IF:0,6 ; Q3)	3	68,3,393-397	2016
10	<i>First-principles Study on the Magnetic Properties of Gd doped Bismuth-Telluride</i>	02	Có	Journal of The Korean Magnetics Society /ISSN: 1598-5385;e-ISSN2233-6648	ESCI		26(2),39-44	2016
11	<i>Về đặc trưng cấu trúc tinh thể và trạng thái nền của một số vật liệu trong tính toán lý thuyết</i>	01	Có	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên /ISSN: 2354-0575			N/A, 11,69-73	9/2016

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, Trang	Năm công bố
12	<i>Role of O and Se defects in the thermoelectric properties of bismuth oxide selenide</i>	02	Có	Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979 e-ISSN:1089-7550	SCI (IF:2,3 ; Q1)	10	120, N/A, 19510 5-1-19510 5-5	2016
13	<i>Tuning the Electronic Structure of Si_{1-x}Ge_x Alloys</i>	03	Có	VNU Journal of Science: Mathematics – Physics /ISSN: 2615-9341 e-ISSN:2588-1124			32,4,5 7-62	2016
14	<i>Enhancement of the thermoelectric performance of oxygen substituted bismuth telluride</i>	02	Có	Journal of Applied Physics/ISSN: 0021-8979 e-ISSN: 1089-7550	SCI (IF:2,3 ; Q2)	4	122,24 5104-1-24510 4-5	2017
15	<i>Hiệu ứng nhiệt điện trên vật liệu bán dẫn n-type tạo thành từ thay thế pb trong bismuth telluride</i>	03	Có	Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017/ISBN: 978-604-95-0326-9			Quyển 2,798-801	2017
16	<i>Electronic structure and thermoelectric properties of Bi₂Se₃ under oxygen substitution</i>	02	Có	Science Journal of Metropolitan University /ISSN: 2354-1504			N/A, 20, 93	12/2017
17	<i>Tính thể nano đơn pha Si_{1-x}Ge_x trong tính toán lý thuyết phiếm hàm mật độ sử dụng gần</i>	04	Có	Tạp chí Khoa Học Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội			NA, 53, 19-21	2/2018

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, Trang	Năm công bố
	<i>đúng mật độ địa phương</i>			2/ISSN: 1859-2325				
18	<i>Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu sự hình thành tinh thể nano hợp kim Si-Ge</i>	05	Không	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội /ISSN: 2354-1083			N/A, 124, 63-67	2018
19	<i>Discussion on thermoelectric economy and research of bismuth telluride</i>	02	Có	Hanoi Metropolitan university: Scientific Journal/ISSN: 2354-1504			N/A, 24, 89-98	6/2018
20	<i>Optimal carrier concentration for high thermoelectric performance of lead substituted bismuth telluride in p-type doping</i>	01	Có	Communication in Physics /ISSN: 0868-3166			28, 02, 169-177	2018
21	<i>Về giới hạn trên của hệ số phẩm chất nhiệt điện không thứ nguyên của Bi₂Te₃</i>	01	Có	Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (spms 2019)/ISBN: 978-604-98-7505-2			Quyển 1 , 211-214	2019
22	<i>Bàn về cấu trúc vùng năng lượng của Si và Ge với các ô cơ sở siêu mạng, Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (spms 2019)</i>	01	Có	Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (spms 2019)/ISBN: 978-604-98-7505-2			Quyển 1 , 206-210	2019

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, Trang	Năm công bố
23	<i>Effect of external static electric field on some properties of iron thin film</i>	02	Có	Hanoi Metropolitan university: Scientific Journal/ISSN: 2354-1504			N/A, 35, 54-62	11/2019
24	<i>Temperature and carrier concentration dependence of thermoelectric properties of GeBi₄Te₇</i>	02	Có	Journal of the Korean Physical Society/ISSN: 0374-4884; e-ISSN:1976-8524	SCI (IF:0,6 ; Q3)		74,3,2 56-260	2019
25	<i>Electrically controlled magnetism in iron thin film</i>	01	Có	IOPconference Series/ISSN:1742-6588; eISSN:1742-6596	Scopus		1506, 012009	2020
26	<i>Electronic Thermal Conductivity and Thermoelectric Performance of PbBi₄Te₇</i>	01	Có	VNU Journal of Science: Mathematics - Physics /ISSN: 2615-9341			Accepted for	2020
27	<i>Valance band maximum and thermoelectric properties of Bi₂O₂Se: first-principles calculations</i>	01	Có	Communication in Physics /ISSN: 0868-3166			30 , 5,	2020

Ghi chú: N/A: tạp chí/kỷ yếu không định danh thông tin này.

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: **04 bài**

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với UV chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với UV chức danh GS.

7.2. Bảng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
Không có				

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận	Cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, các số TT tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): 0

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): 0

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): 0

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

.....

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

.....

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

.....

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐ ; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội , ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ



Trần Văn Quảng